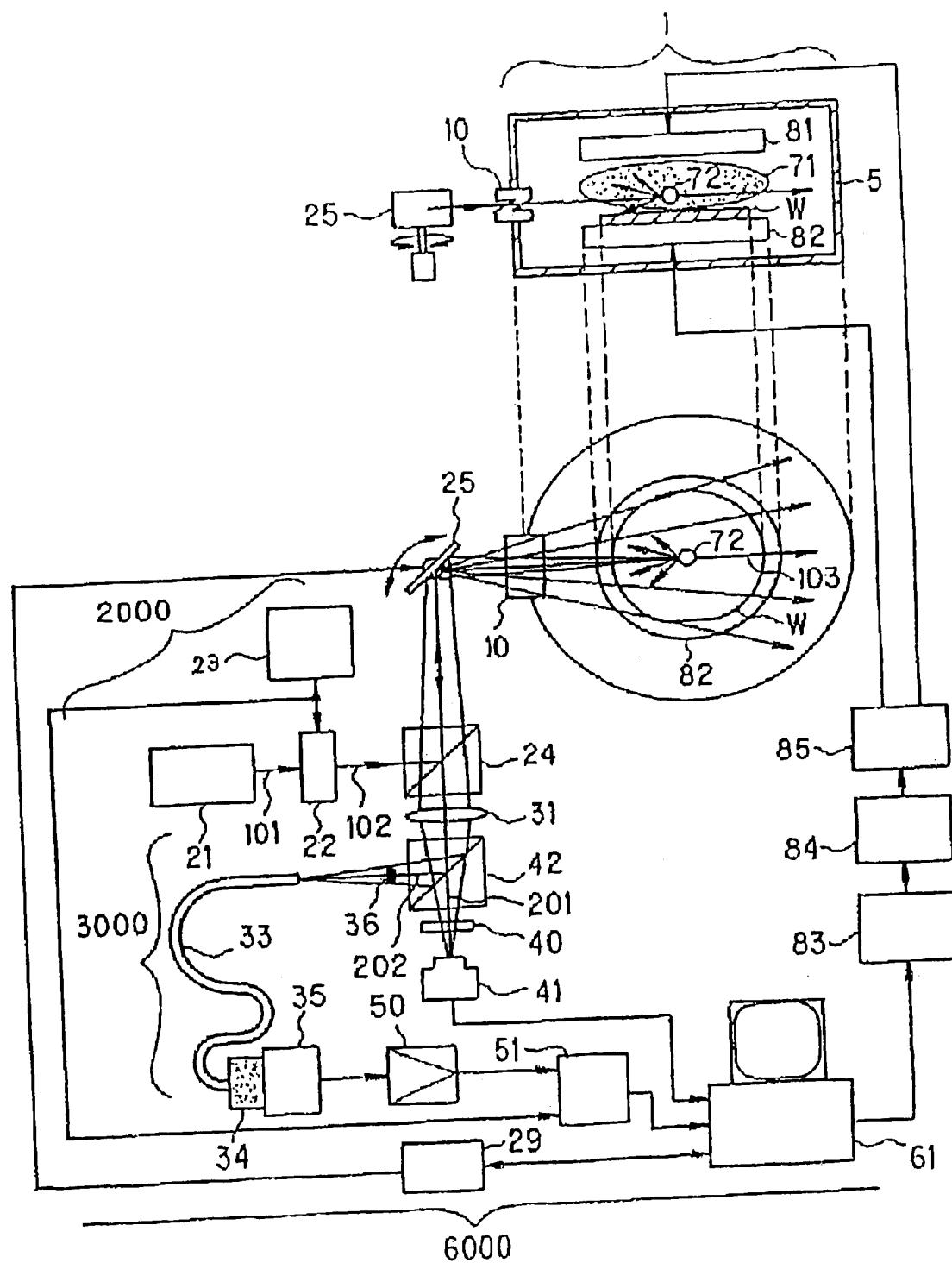


ファイル名 = D99008581A1.cl

【書類名】 図面

【図 1】

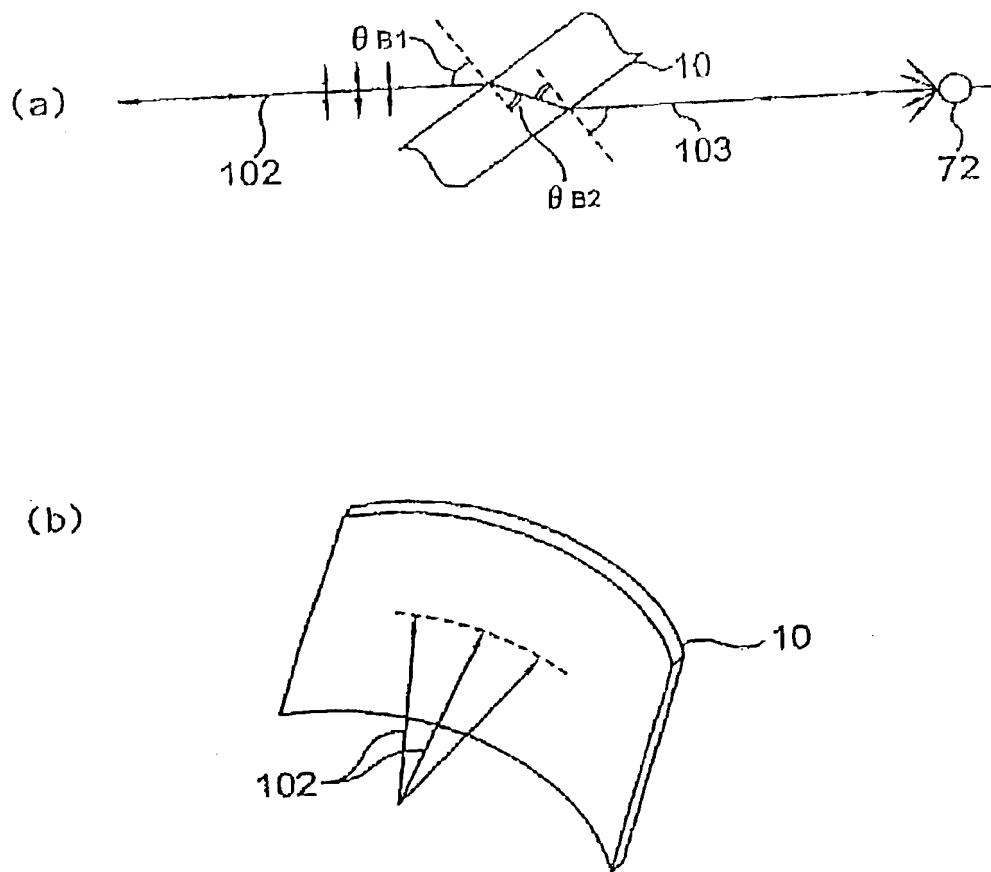
図 1



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 2】

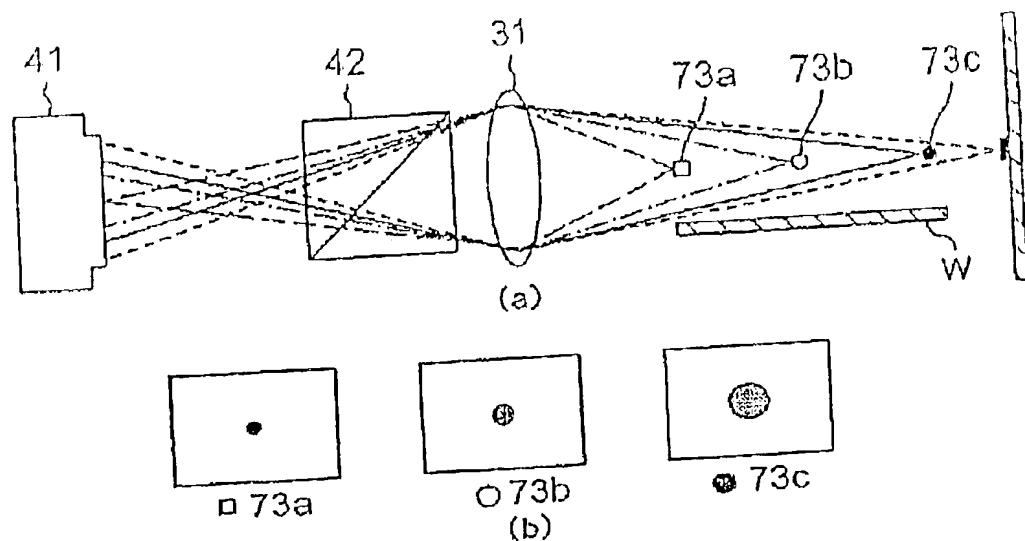
図 2



ファイル名 = D99008581A1.e1

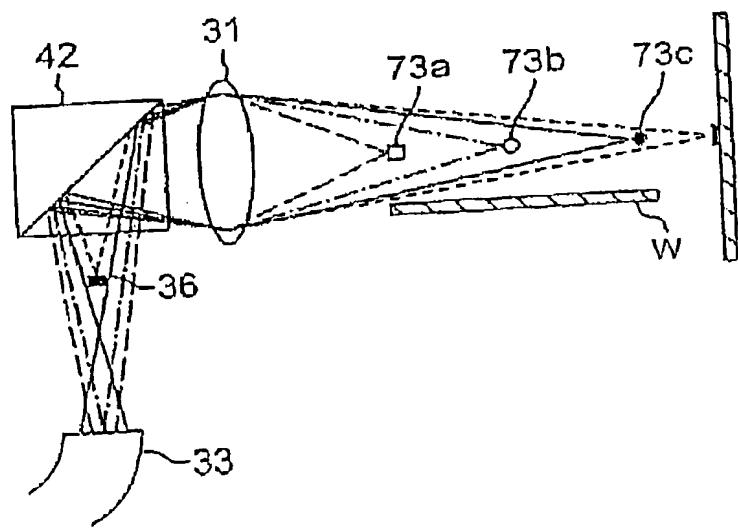
【図3】

図3



【図4】

図4



2000/12/15 17:49:48

販 品 質 検査

No. 2764 P-31

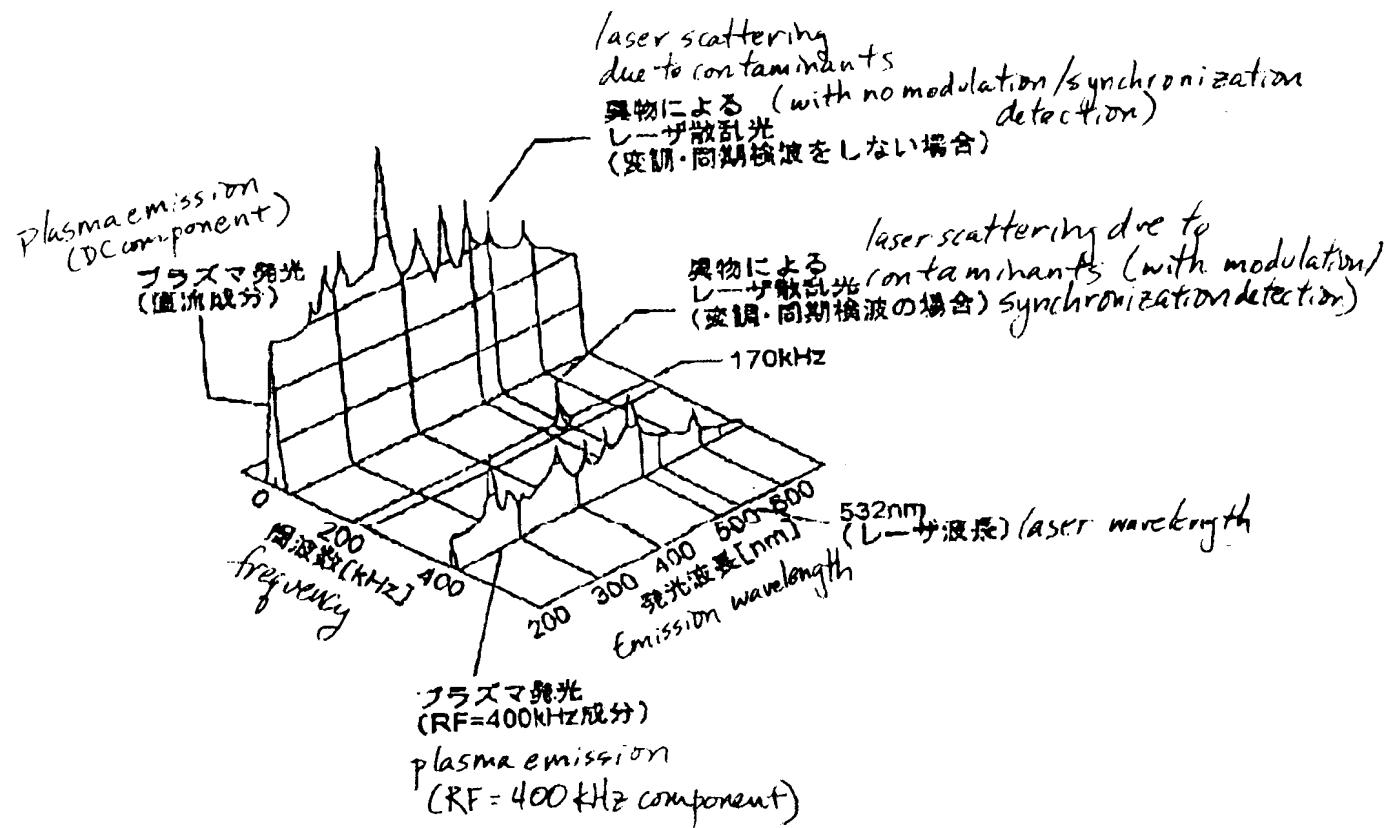
出 1998 年 6 月

ページ (42 / 61)

ファイル名 = D99008581A1.01

[図 5]

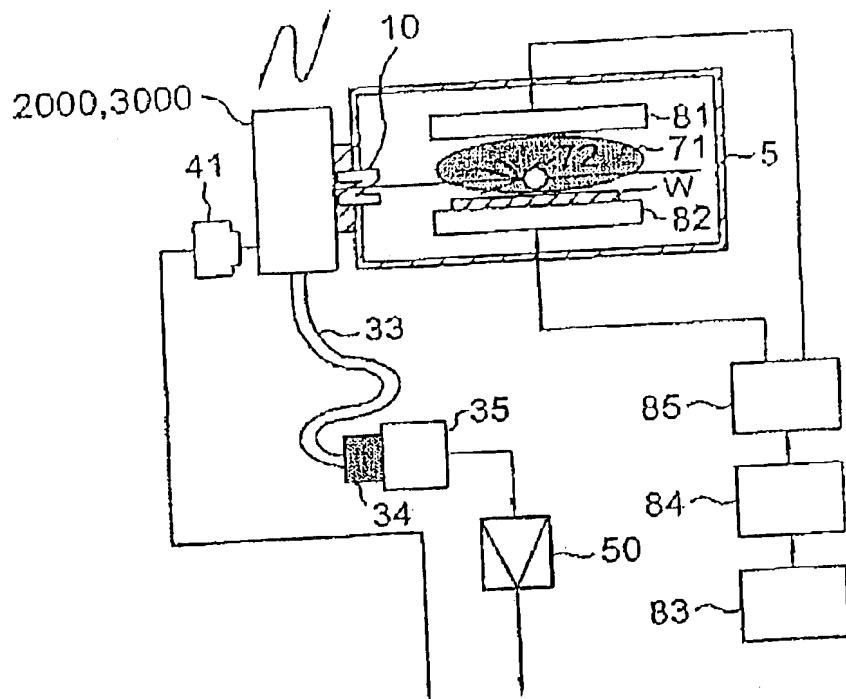
図 5 Fig. 5



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 6】

図 6



2000年12月15日 17時19分

3 機械検査

No. 3764

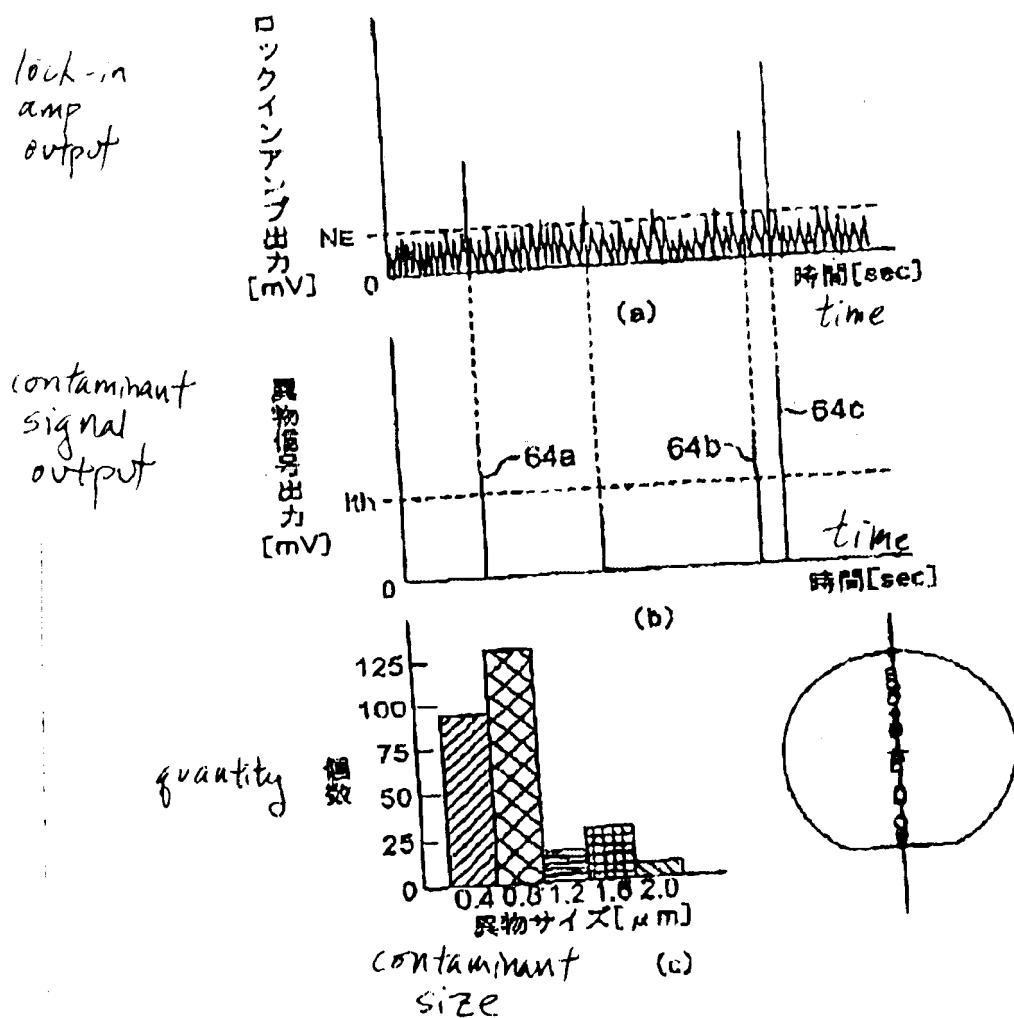
出版書類

ページ (14 / 61)

ファイル名 = 039008581A1.e1

(図7)

図7 Fig. 7



2000-12-15 17:01:59

並列測定

No. 8764 E. 54

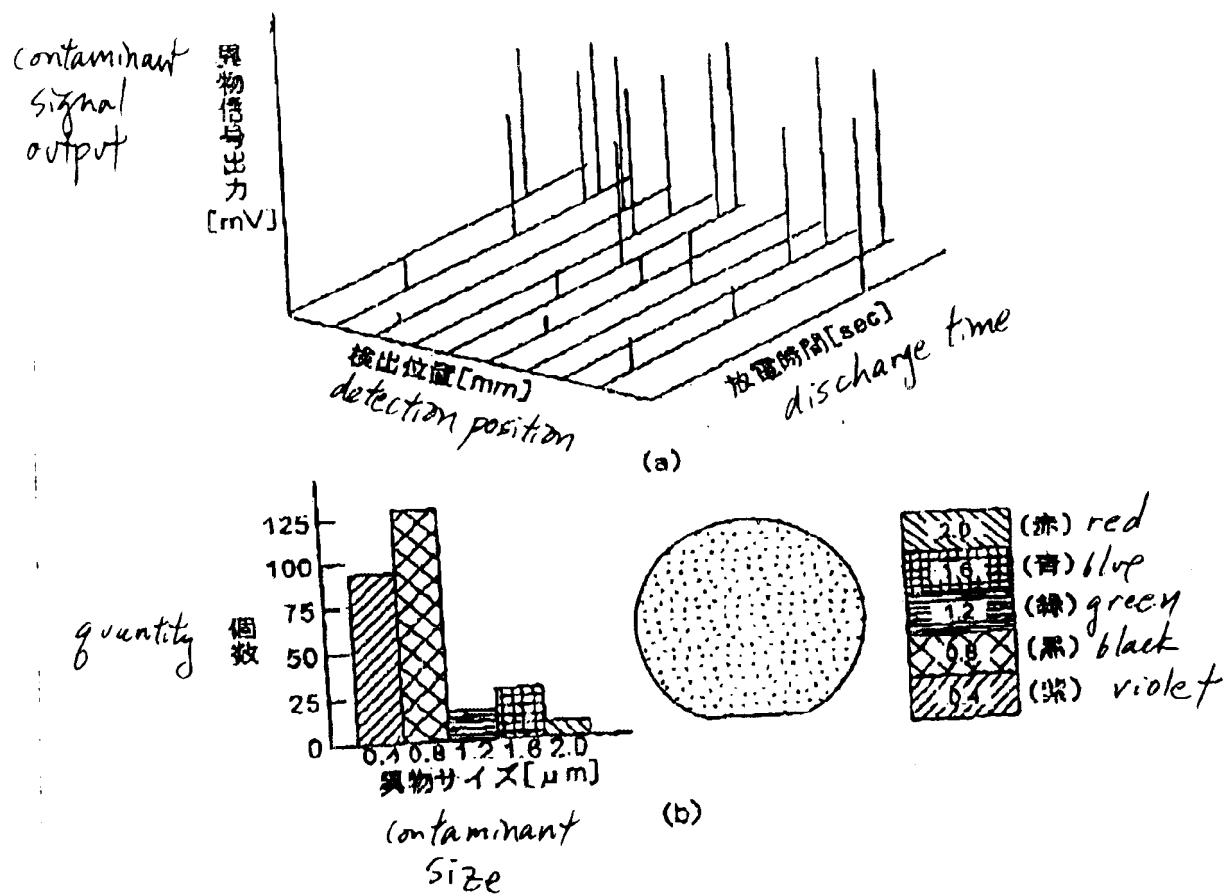
出原直英

ページ(45 / 61)

ファイル名 = D99008681A1.e1

[図 8]

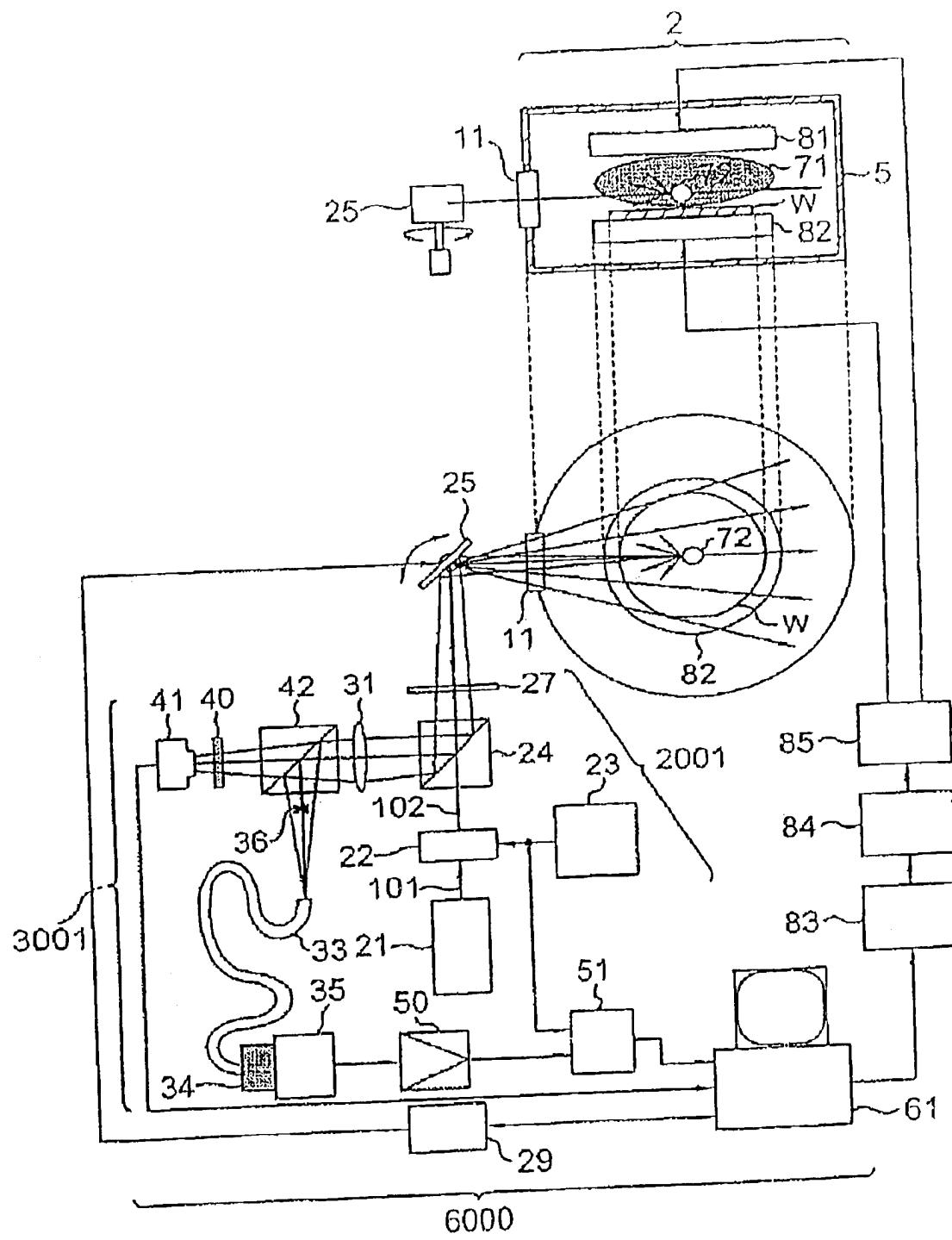
図 8 Fig 8



ファイル名 = D99008581A1.e1

[図 9]

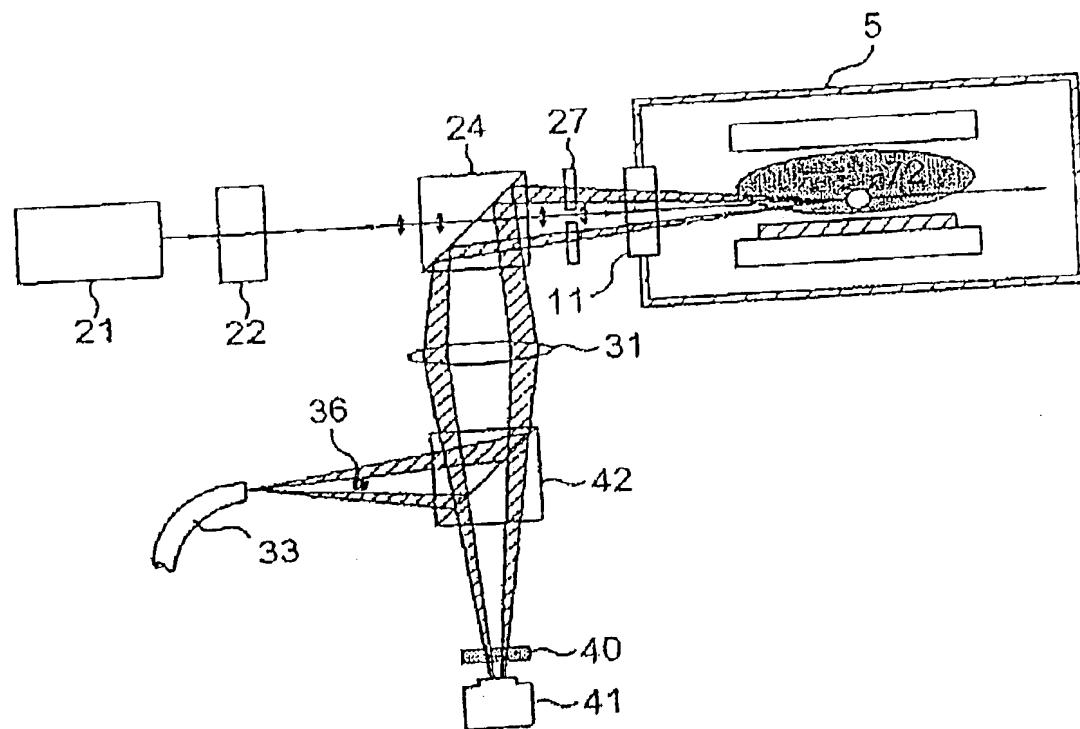
义 9



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 10】

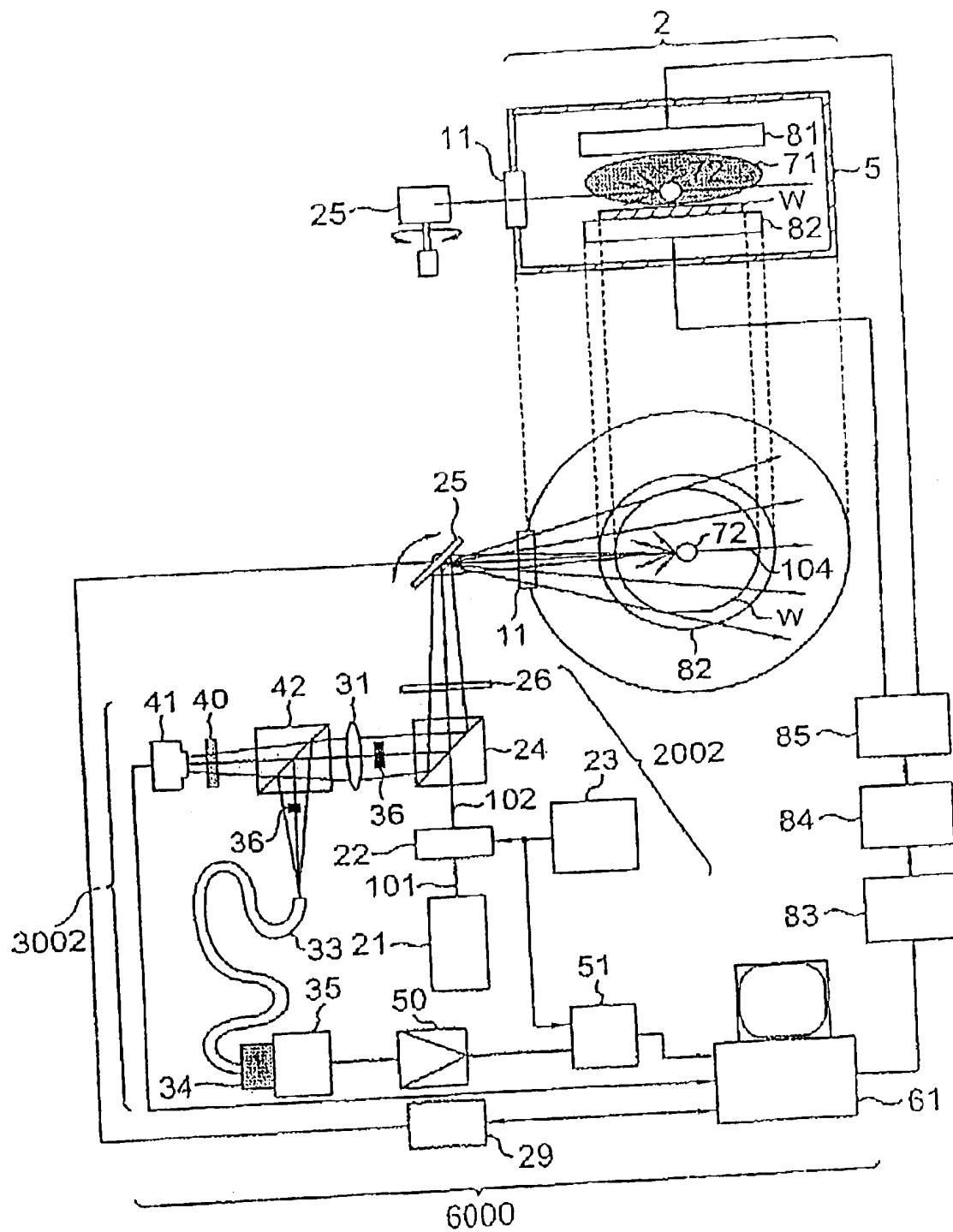
図 10



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 1 1】

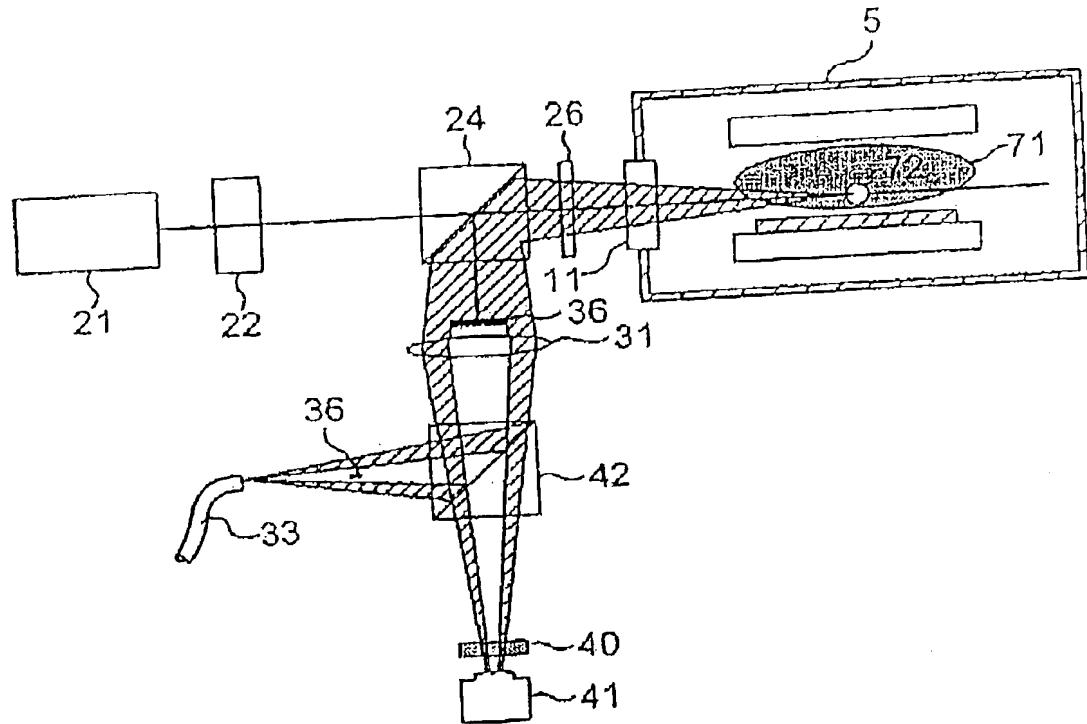
図 1 1



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 12】

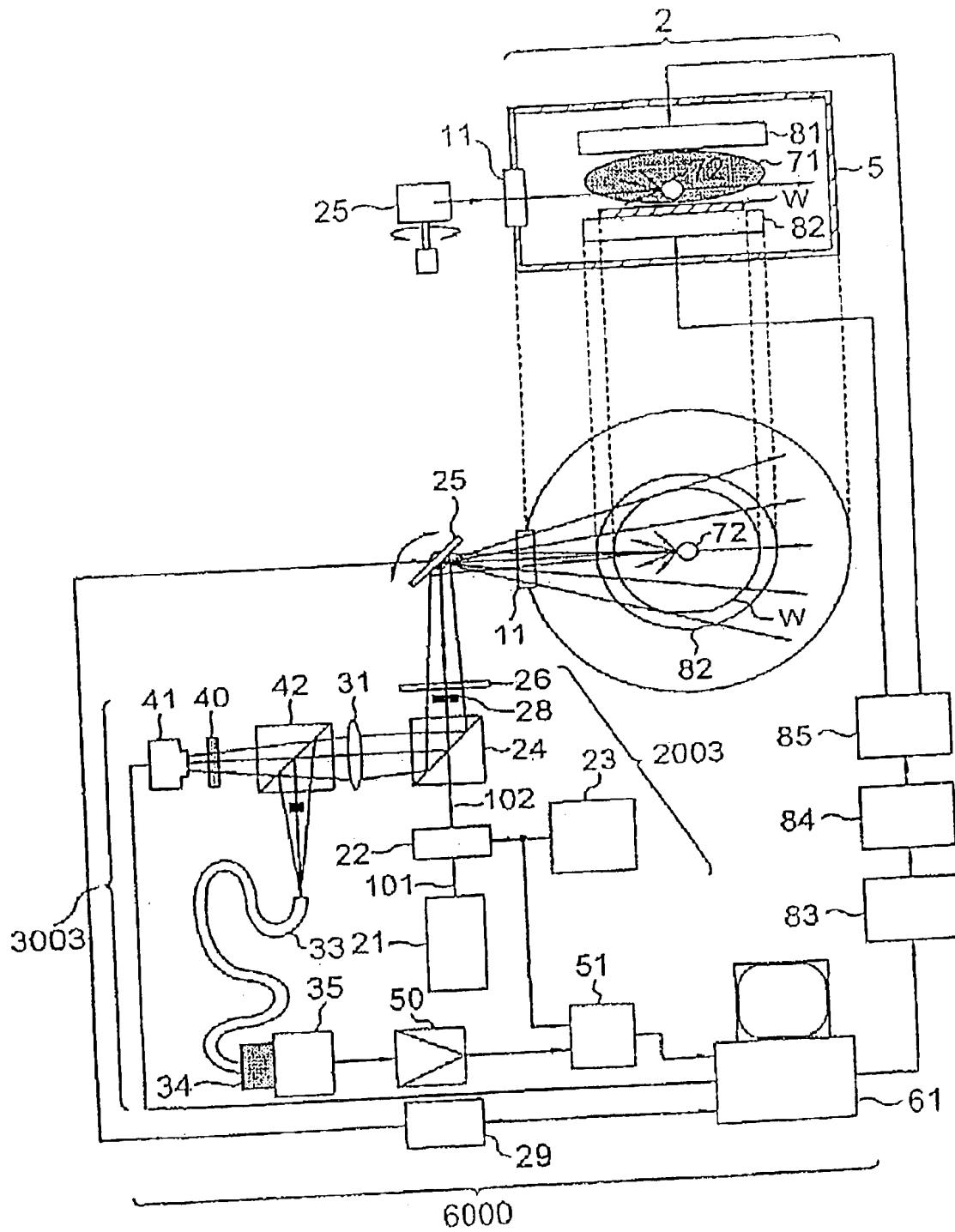
図 12



ファイル名 = D99008581A1.e1

[図 13]

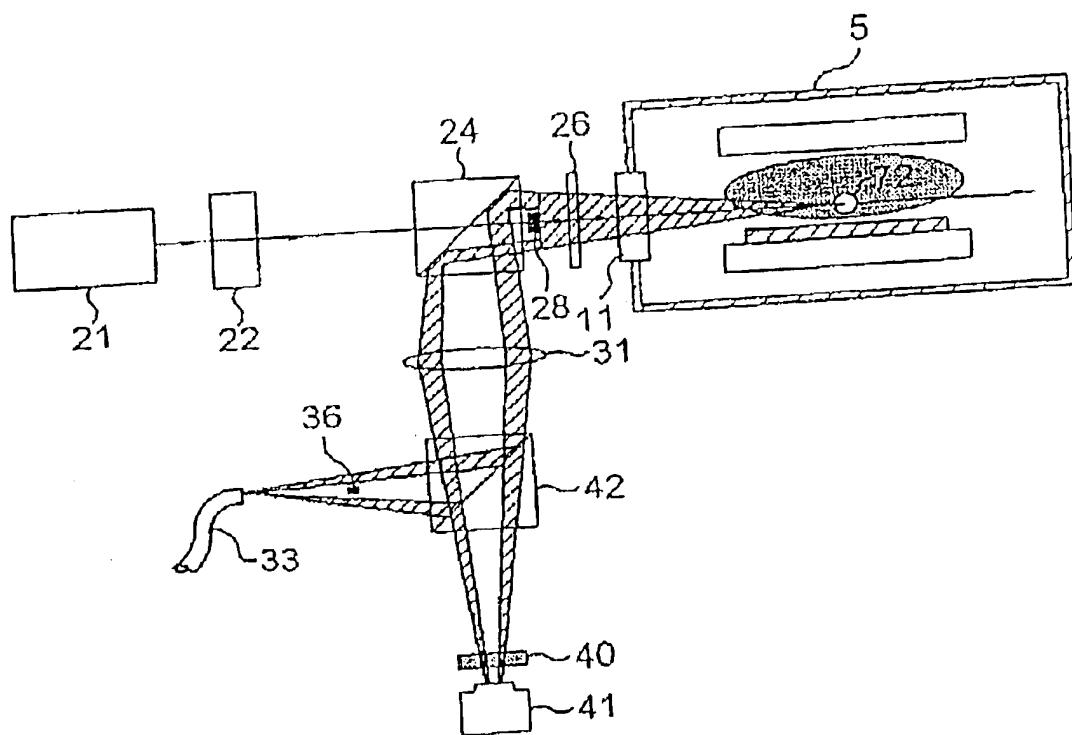
図 13



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 14】

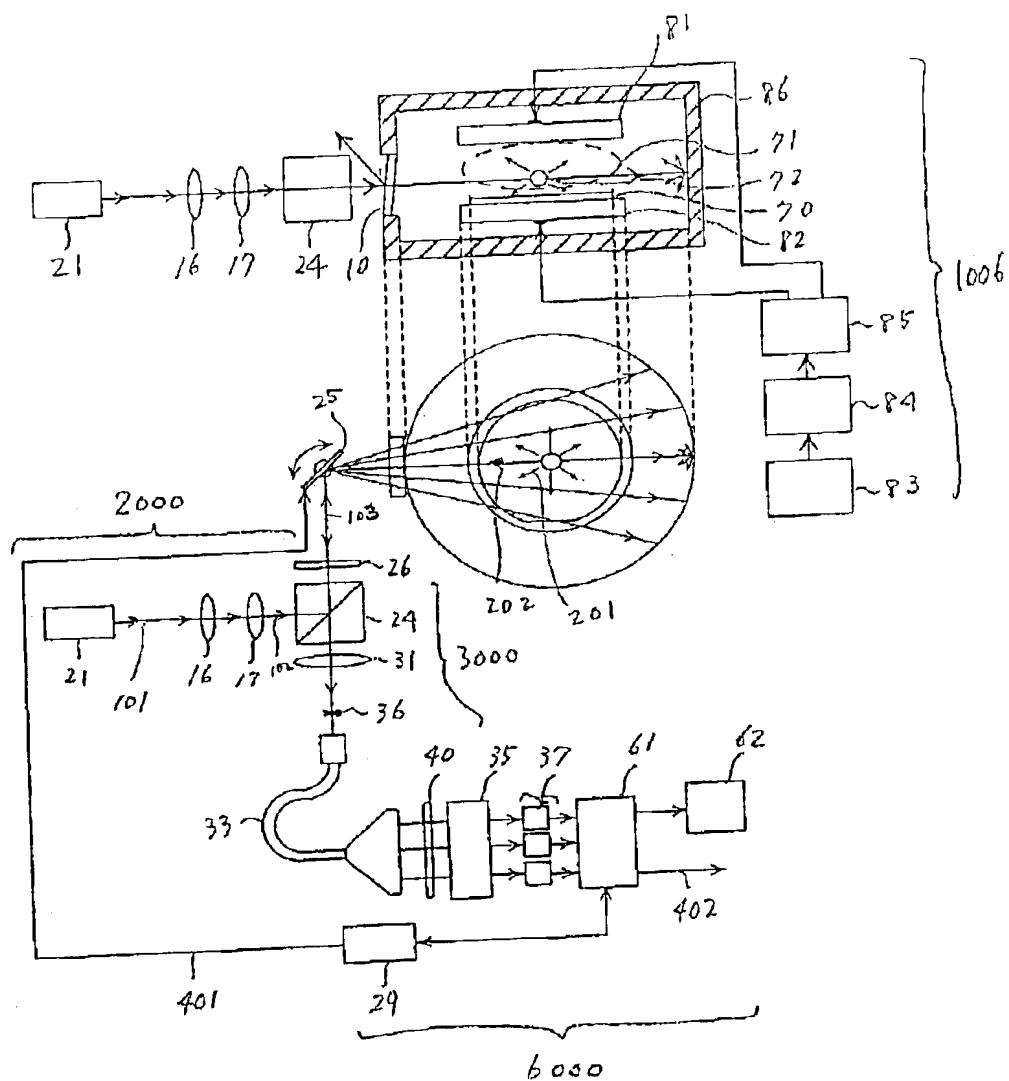
図 14



ファイル名 = D99008581A1.e1

[図 15]

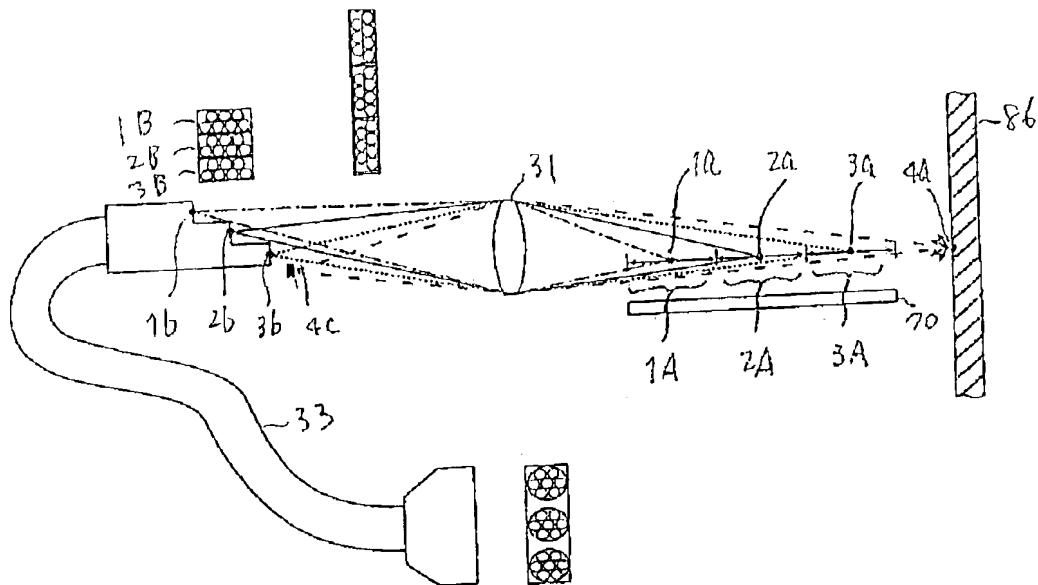
図 15



ファイル名 = D99008581A1.e1

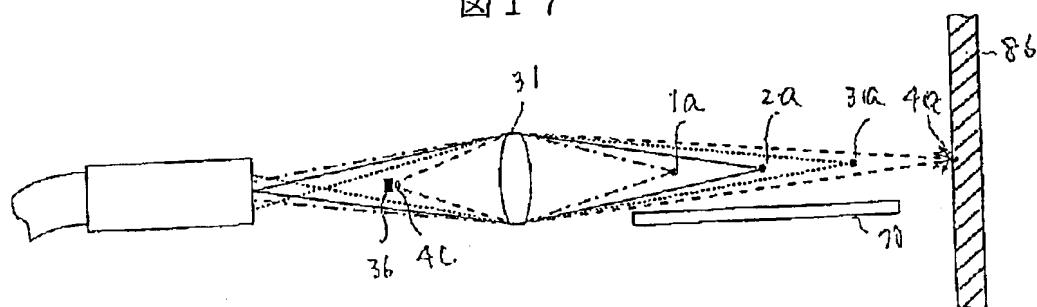
【図 1 6】

図 1 6



【図 1 7】

図 1 7



2000/12/15 3:17:59

近畿本部

M: 8754 P: 59

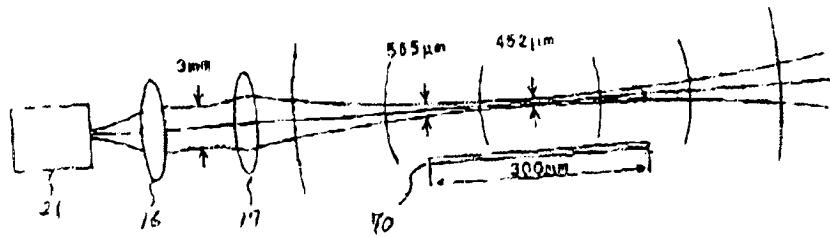
日本語

ページ(54 / 61)

ファイル名 = D99008591A1.e1

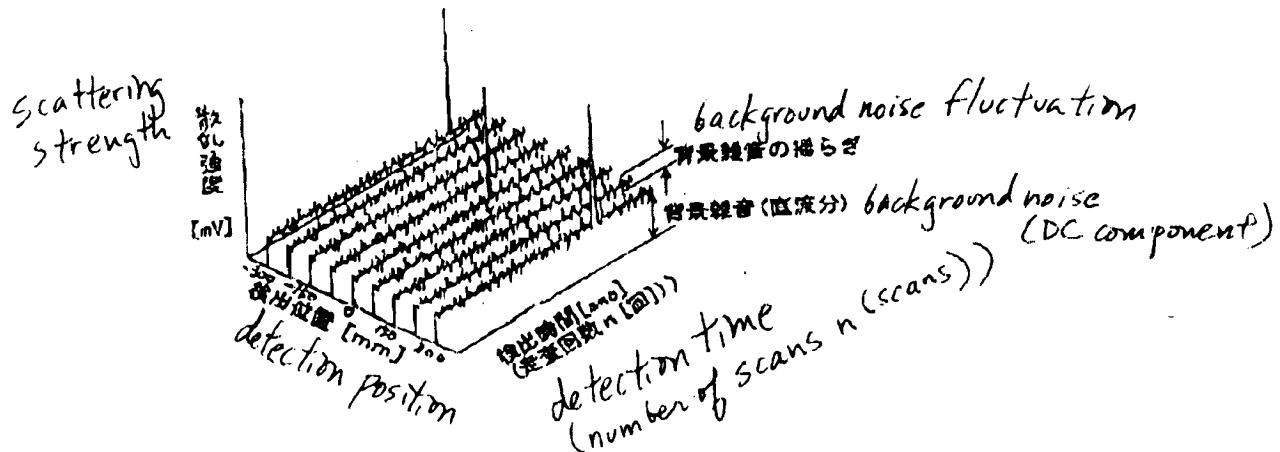
[図 18]

図 18



[図 19]

図 19 Fig. 19



2000/12/15 03:17:21

E-mail

No. 3764 E-64

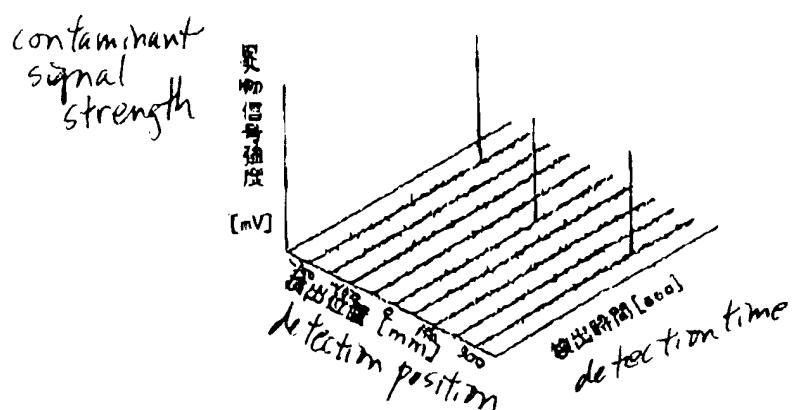
出願書類

ページ(55 / 61)

ファイル名 = D99C00581A1.m1

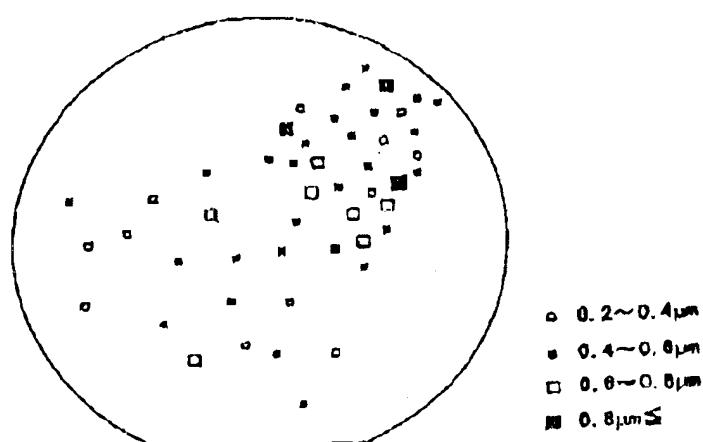
[図 2.0]

図 2.0



[図 2.1]

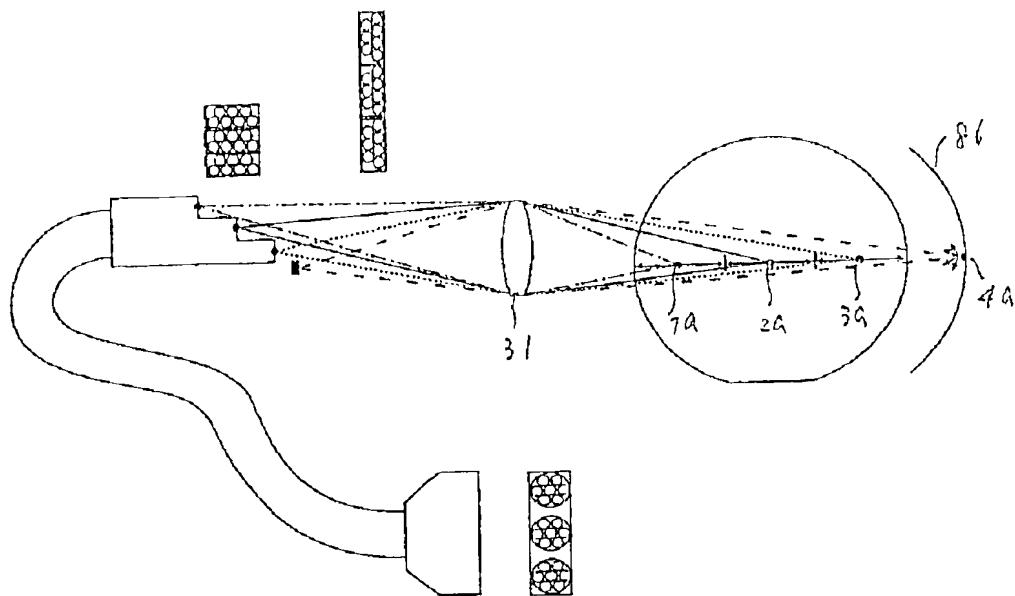
図 2.1



ファイル名 = D99008581A1.e1

[図 22]

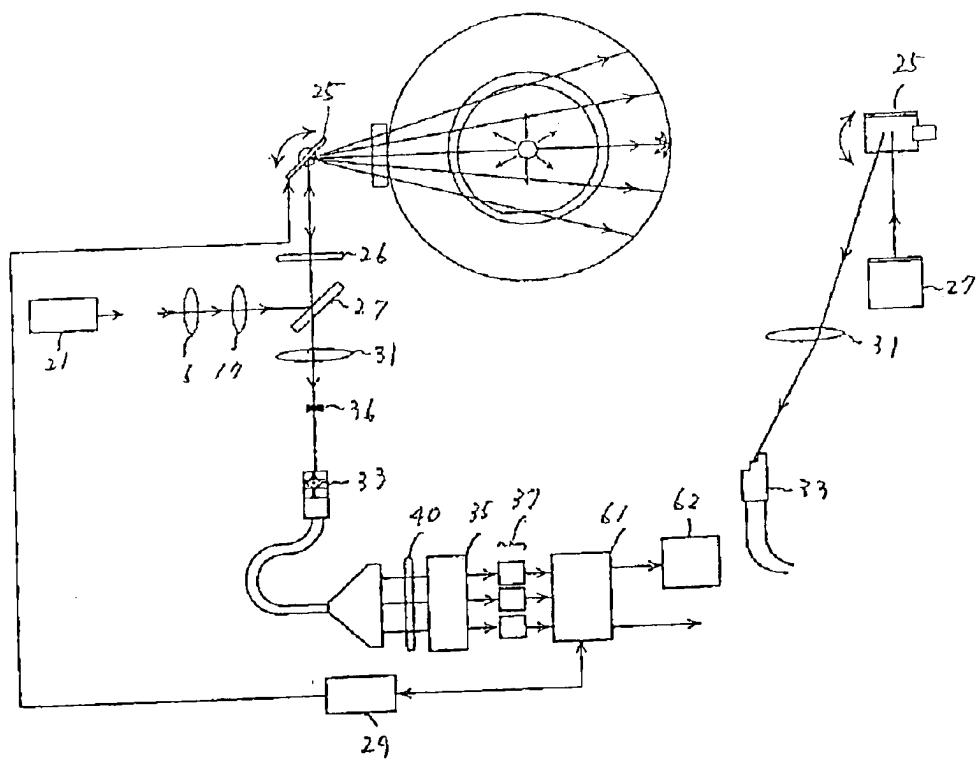
図 22



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 23】

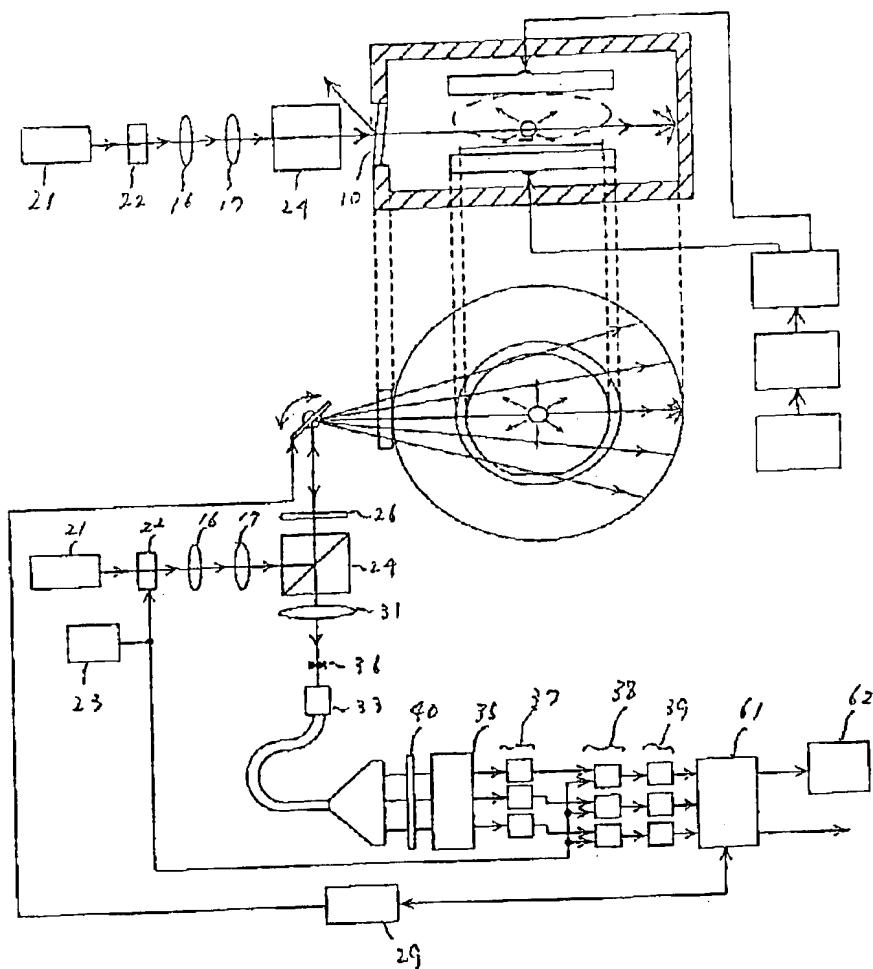
図 23



ファイル名 = D99008581A1.e1

【図 24】

図 24



2001年7月22日

立地部会議

No. 9761 66

Fig. 25

図 25

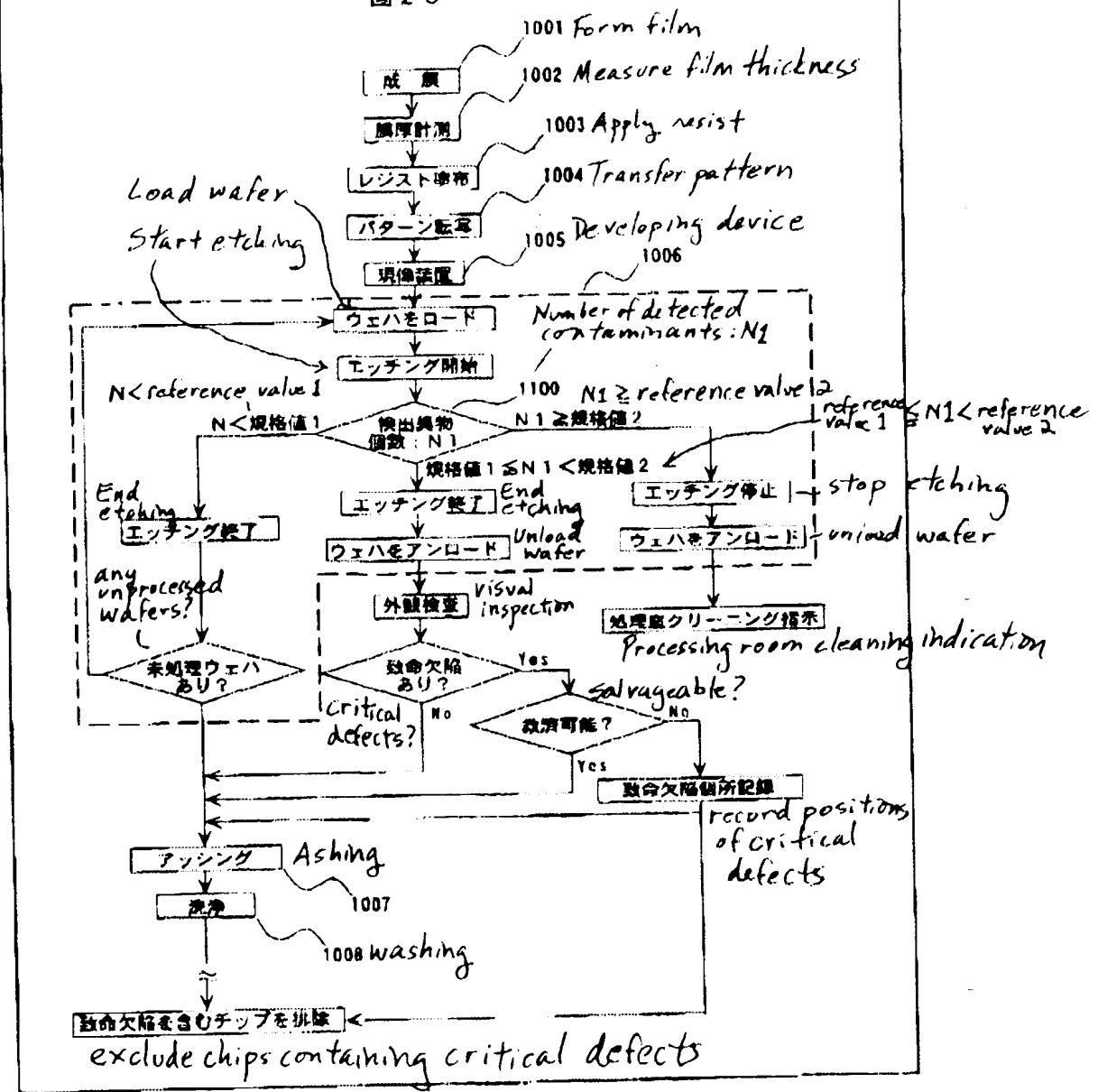


図26

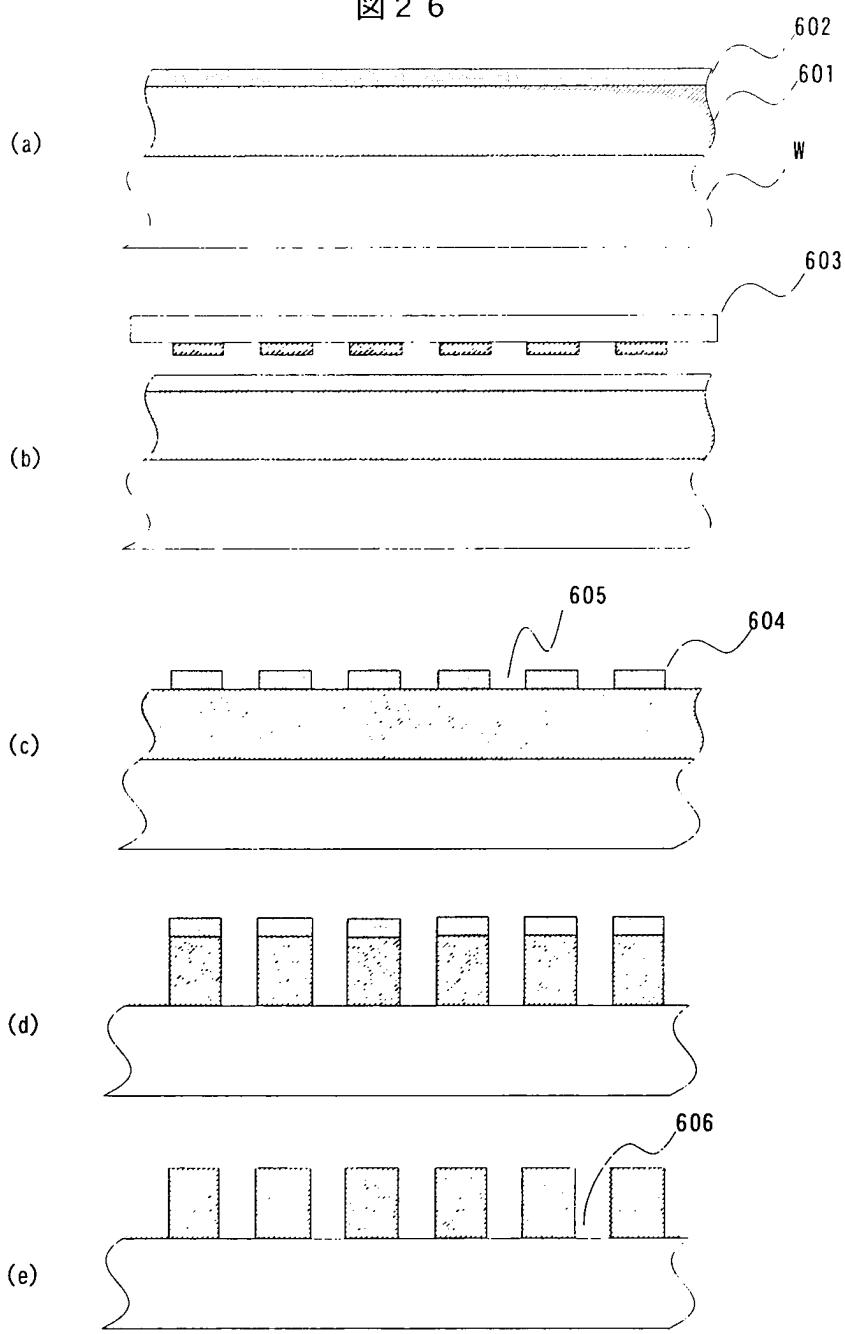


図 2 7

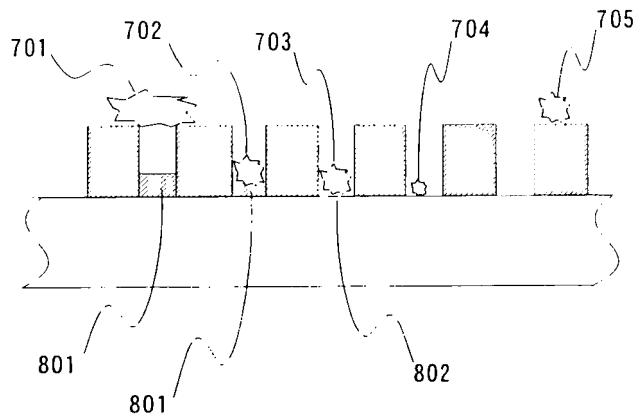
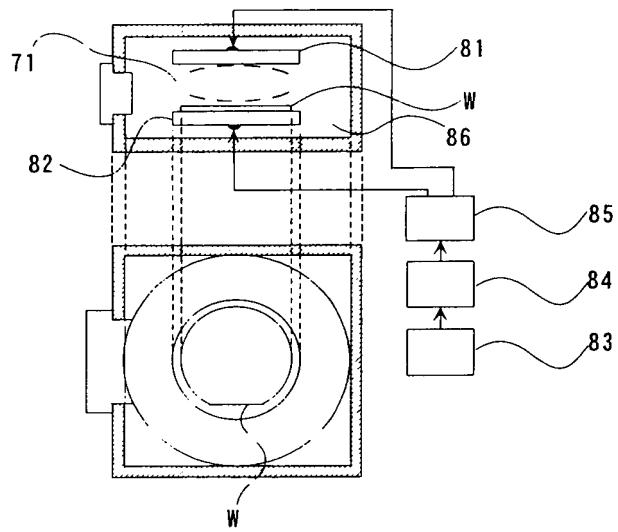
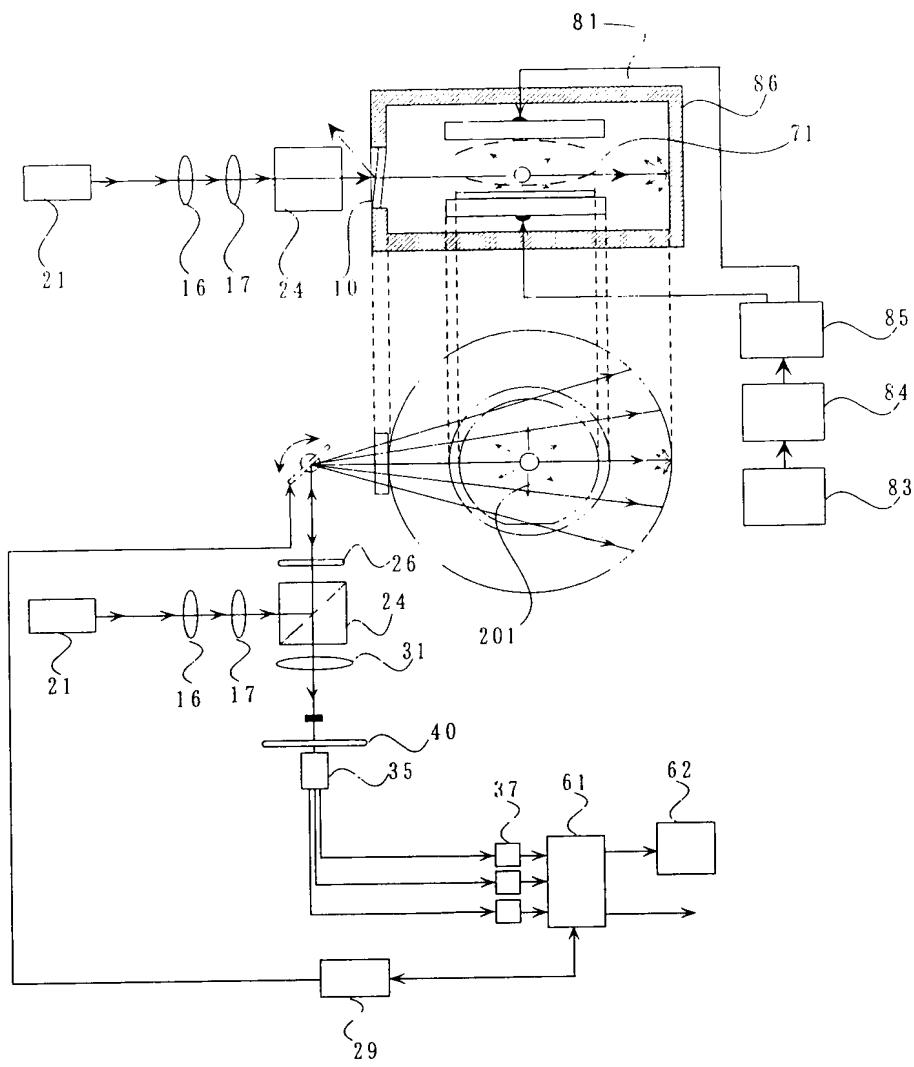


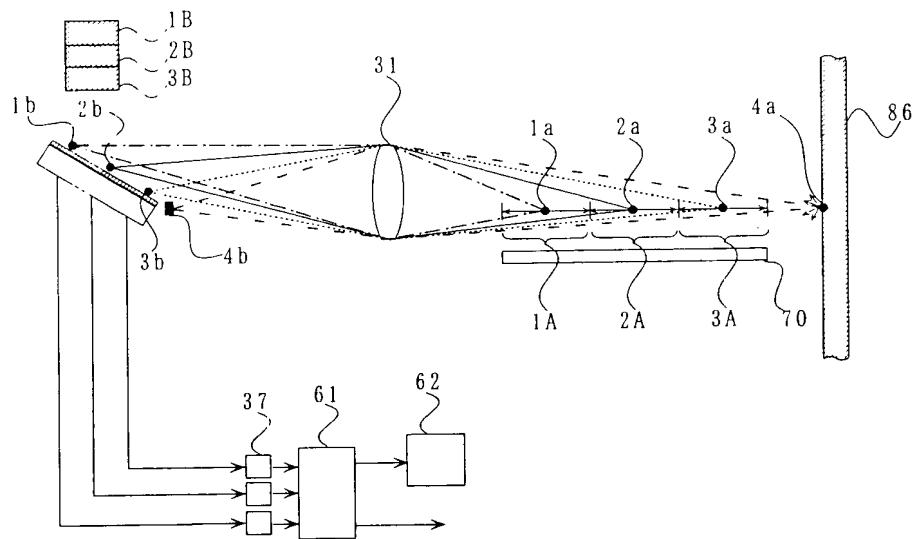
図 2 8



【図29】



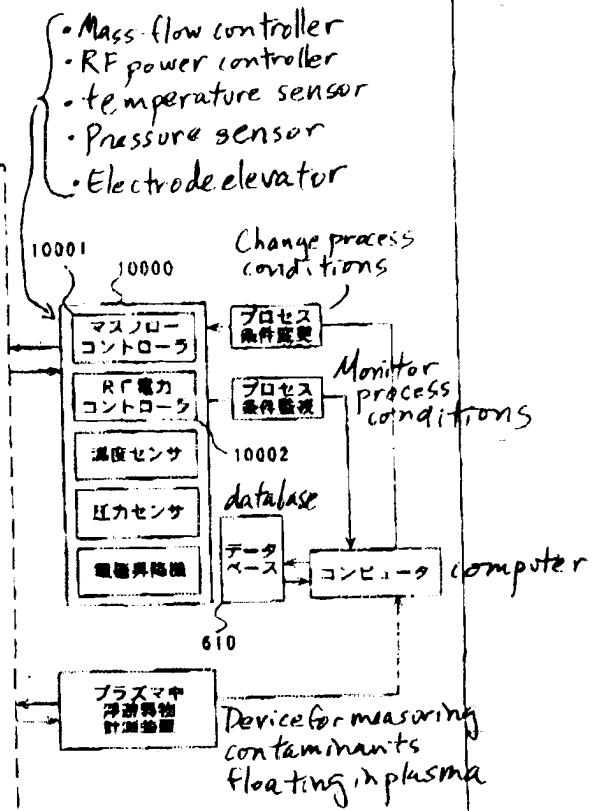
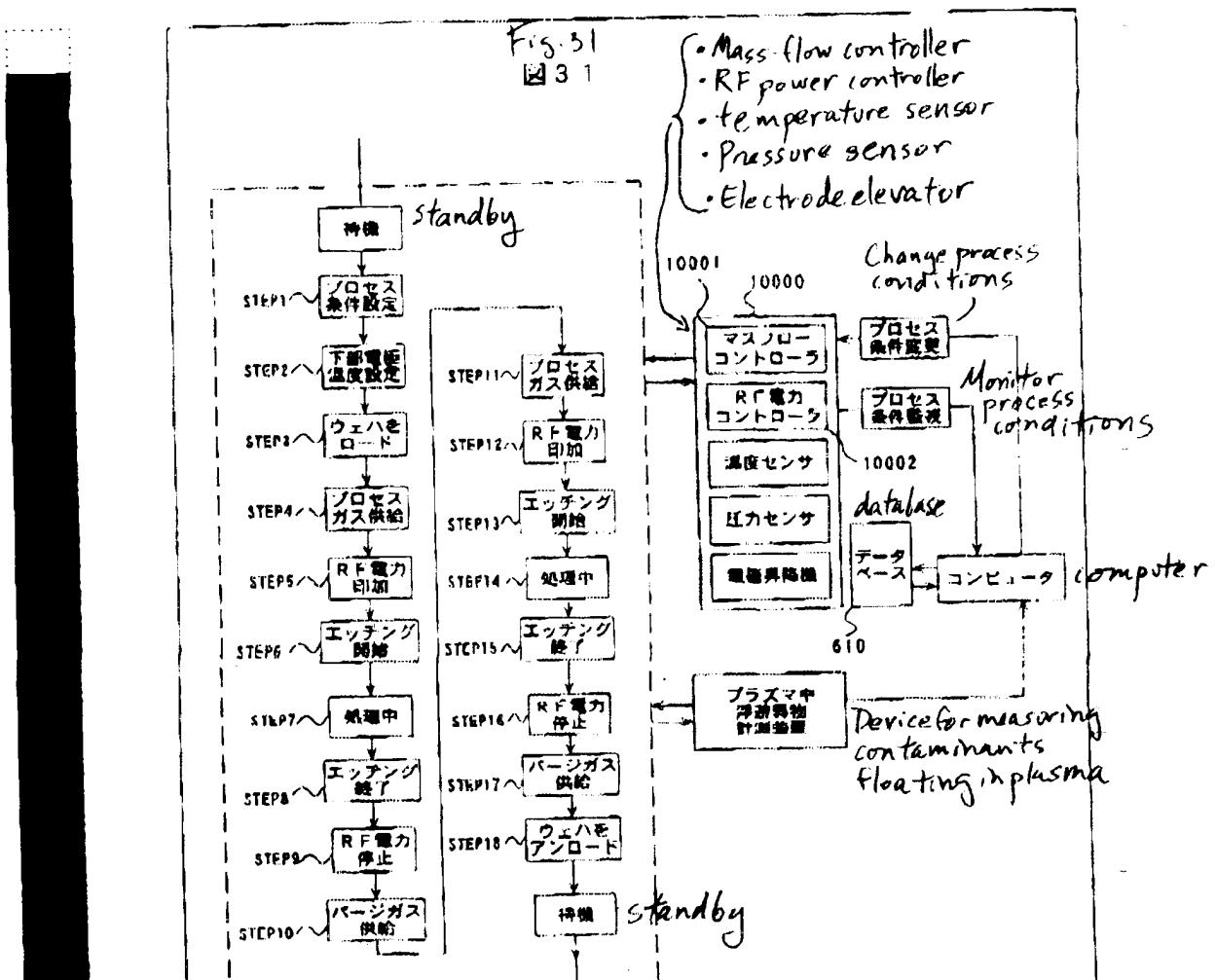
【図30】



2001/3/27 00:17:20

回路 組成部品

No. 3764 2 73



Step 1: Set up process conditions

Step 2: Set lower electrode temperature

Step 3: Load wafer

Step 4: Supply process gas

Step 5: Apply RF power

Step 6: Begin etching

Step 7: Processing

Step 8: Etching completed

Step 9: Stop RF power

Step 10: Supply purge gas

Step 11: Supply process gas

Step 12: Apply RF output

Step 13: Begin etching

Step 14: Processing

Step 15: Etching completed

Step 16: Stop RF power

Step 17: Supply Purge gas

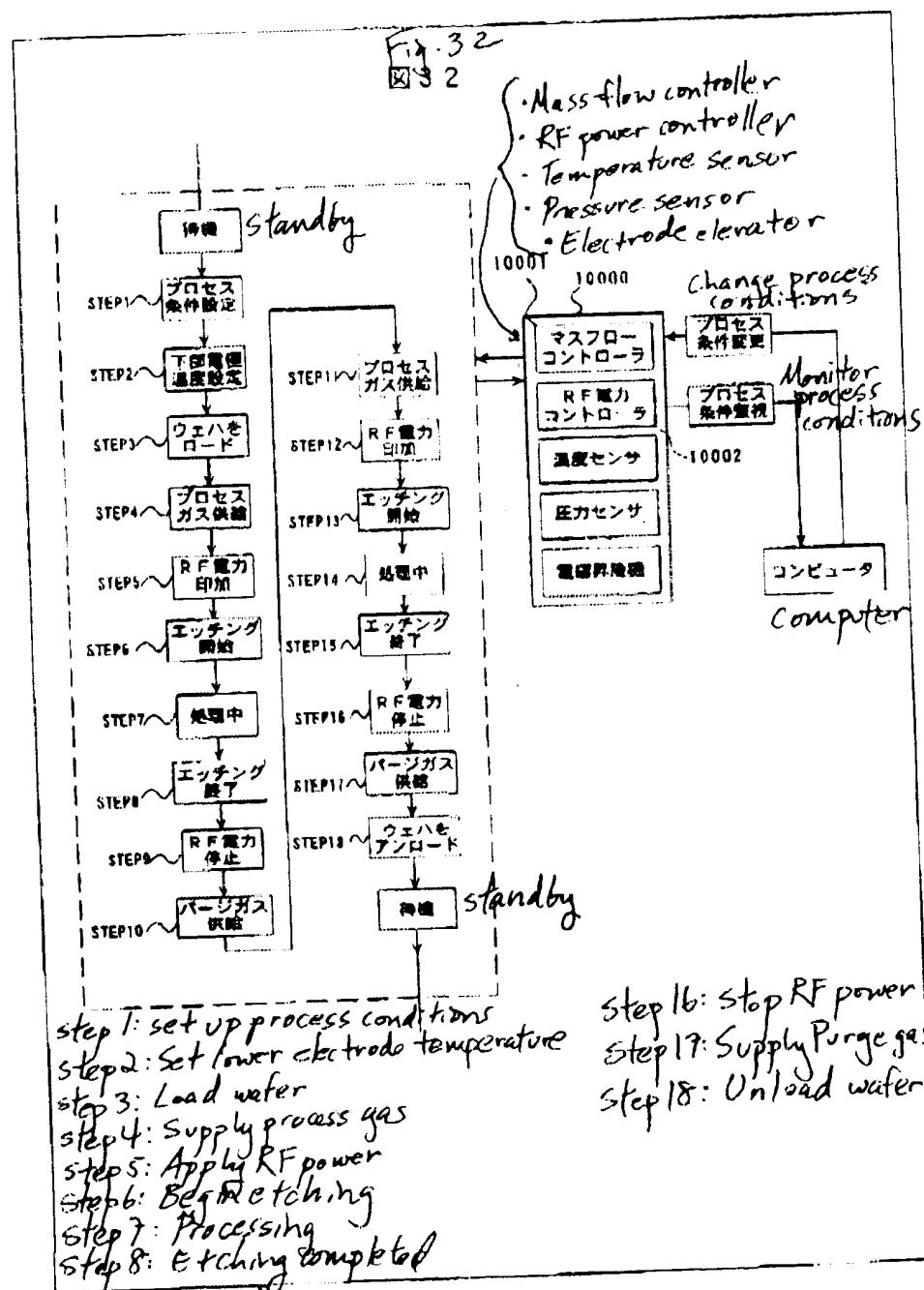
Step 18: Unload wafer

2001/10/30 10:02:34

RF Etch

No. 0761

76



step 1: set up process conditions
 step 2: Set lower electrode temperature
 step 3: Load wafer
 step 4: Supply process gas
 step 5: Apply RF power
 step 6: Begin etching
 step 7: Processing
 step 8: Etching completed

Step 16: Stop RF power
 Step 17: Supply Purge gas
 Step 18: Unload wafer

Step 9: Stop RF power
 Step 10: Supply purge gas
 Step 11: Supply process gas
 Step 12: Apply RF output
 Step 13: Begin etching
 Step 14: Processing
 Step 15: Etching completed